

	<p>SI4936BDY-T1-E3</p> <p>Hersteller-Teilenummer: SI4936BDY-T1-E3</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET 2N-CH 30V 6.9A 8-SOIC</p> <hr/> <p>Datenblätter:  SI4936BDY-T1-E3.pdf</p> <hr/> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 24184 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI4936BDY-T1-E3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 30V 6.9A 8-SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	24184 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	35 mOhm @ 5.9A, 10V
Leistung - max	2.8W
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Andere Namen	SI4936BDY-T1-E3CT
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	33 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	530pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	15nC @ 10V
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 N-Channel (Dual) 30V 6.9A 2.8W Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	6.9A
Basisteilenummer	SI4936

SI4936BDY-T1-E3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI4936BDY-T1-E3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI4936BDY-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI4936BDY-T1-E3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI4936BDY-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 30V 6.9A 8-SOIC</p>	 <p>SI4936C VISHAY SI4936C VISHAY</p>	 <p>SI4936BDY SOP8 SI4936BDY SOP8</p>	 <p>SI4936BDY-T1-E3 VISHAY SI4936BDY-T1-E3 VISHAY</p>
 <p>SI4936BDY-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 30V 6.9A 8-SOIC</p>	 <p>SI4936ADY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 30V 4.4A 8-SOIC</p>	 <p>SI4936ADY-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 30V 4.4A 8-SOIC</p>	 <p>SI4936ADY-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 30V 4.4A 8-SOIC</p>

SI4936BDY-T1-E3 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort	Electro-Films (EFI) / SI4936BDY-T1-E3 Datenblatt	SI4936BDY-T1-E3-Datenblätter	SI4936BDY-T1-E3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SI4936BDY-T1-E3
	Vishay			
SI4936BDY-T1-E3 Electronic	SI4936BDY-T1-E3-Komponenten	SI4936BDY-T1-E3-Verteiler	SI4936BDY-T1-E3-Bild	SI4936BDY-T1-E3-Teil
SI4936BDY-T1-E3 Preis	SI4936BDY-T1-E3 Hersteller	SI4936BDY-T1-E3 Bild	SI4936BDY-T1-E3 Aktie	SI4936BDY-T1-E3 Inventar
SI4936BDY-T1-E3 Neu	SI4936BDY-T1-E3 Original	SI4936BDY-T1-E3 garantiert	SI4936BDY-T1-E3 RFQ	SI4936BDY-T1-E3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited